


(Dimensions in mm)

許容チャネル損失の周囲温度による変化
MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION
CURVE

項 目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン・ソース破壊電圧	$V_{DS(sat)}$	$I_D=50\mu A$, $V_{G1S}=-6V$, $V_{G2S}=0$	12	—	—	V
ゲート 1・ソース破壊電圧	$V_{GS1(sat)}$	$I_{G1S}=-10\mu A$, $V_{G2S}=V_{DS}=0$	-6	—	—	V
ゲート 2・ソース破壊電圧	$V_{GS2(sat)}$	$I_{G2S}=-10\mu A$, $V_{G1S}=V_{DS}=0$	-6	—	—	V
ゲート 1 遮断電流	I_{G1S}	$V_{G1S}=-6V$, $V_{G2S}=V_{DS}=0$	—	—	-20	μA
ゲート 2 遮断電流	I_{G2S}	$V_{G1S}=-6V$, $V_{G1S}=V_{DS}=0$	—	—	-20	μA
ゲート 1・ソース遮断電圧	$V_{G1S(off)}$	$V_{DS}=5V$, $V_{G2S}=0$, $I_D=100\mu A$	—	—	-6	V
ゲート 2・ソース遮断電圧	$V_{G2S(off)}$	$V_{DS}=5V$, $V_{G1S}=0$, $I_D=100\mu A$	—	—	-6	V
ドレイン電流	I_{DS} *	$V_{DS}=5V$, $V_{G1S}=V_{G2S}=0$	10	—	50	mA
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$V_{DS}=5V$, $V_{G1S}=0$, $I_D=10mA$, $f=1kHz$	10	—	—	mS
入力容量	C_{iss}	$V_{DS}=5V$, $V_{G1S}=V_{G2S}=-6V$, $f=1MHz$	—	1.2	—	pF
出力容量	C_{oss}		—	0.4	—	pF
逆伝達容量	C_{iss}		—	0.02	—	pF
電力利得	PG	$V_{DS}=5V$, $V_{G1S}=0$, $I_D=10mA$	10	15	—	dB
雑音指数	NF	$f=900MHz$	—	1.5	3.0	dB

* The JSK113 is grouped by *I_{ext}* as follows.

721